

### 特点

- 直接连接C-MOS，TTL等。
- 高速开关
- 无二次击穿。

### 应用

- 薄和厚薄膜电路
- 通用快速开关应用。

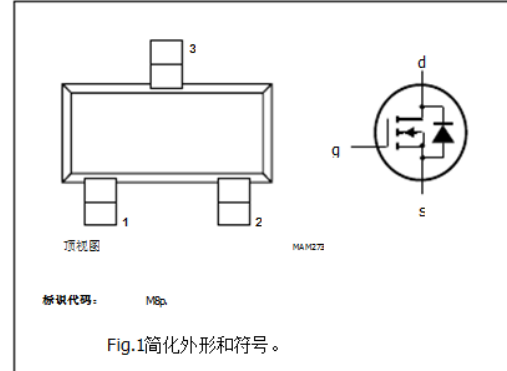
### 描述

N沟道增强型垂直的D-MOS晶体管  
采用SOT23 SMD封装。

小心
该器件采用防静电包装中提供。 栅源输入必须加以保护，防止静电 运输或装卸过程中排出。

### 钉扎 - SOT23

针	符号	描述
1	g	门
2	s	来源
3	d	漏



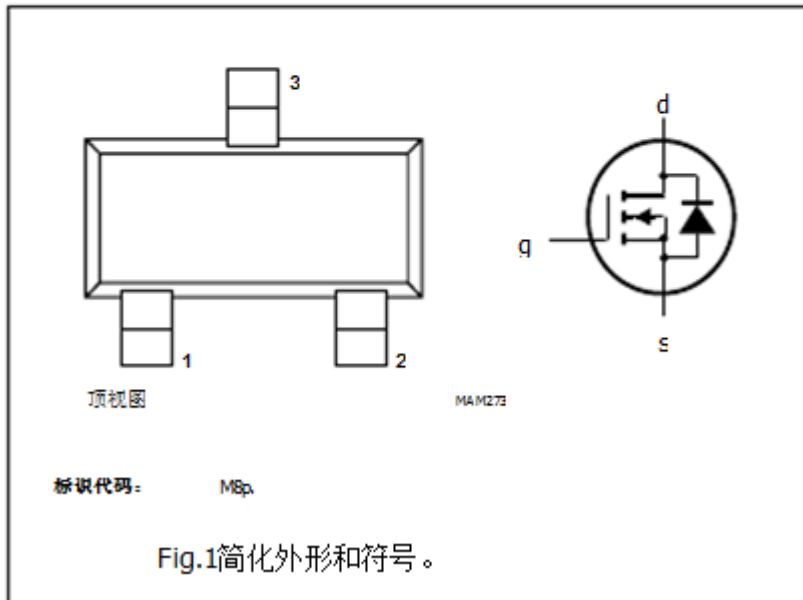
### 极限值

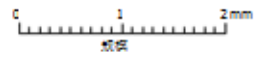
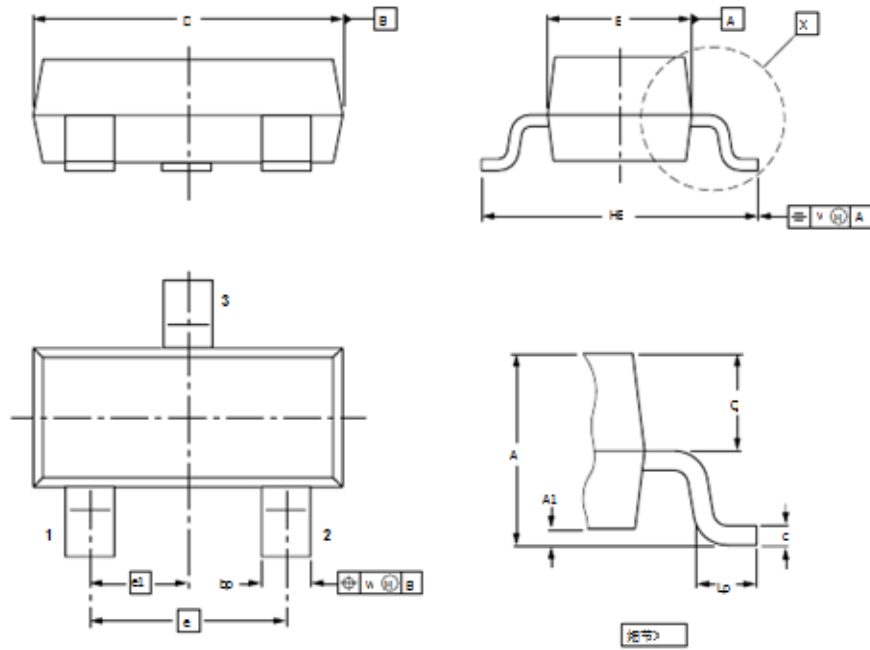
按照绝对最大额定值系统 ( IEC 134 ) 。

符号	参数	条件	分钟。	马克斯。	单位
$V_{DS}$	漏极 - 源极电压 (直流)		-	50	V
$V_{GEC}$	栅极 - 源极电压 (直流)	漏极开路	-	$\pm 20$	V
$I_C$	漏电流 ( DC )		-	100	mA
$I_{DM}$	峰值漏极电流		-	300	mA
$P_{合计}$	总功耗	最多至 $T_{AMB} = 25^{\circ}X$ ; 注1	-	300	mW
		最多至 $T_{AMB} = 25^{\circ}X$ ; 注2	-	250	mW
$T_{存储}$	储存温度		-65	+150	$^{\circ}X$
$T_J$	结温		-	150	$^{\circ}X$

### 钉扎 - SOT23

针	符号	描述
1	g	门
2	s	来源
3	d	漏





外形尺寸 (mm除非给尺寸)

单位	A	A <sub>1</sub> 马克斯	b <sub>p</sub>	c	D	E	e	e <sub>1</sub>	H <sub>c</sub>	L <sub>p</sub>	Q	v	w
mm	1.1 0.9	0.1	0.48 0.38	0.15 0.09	3.0 2.8	1.4 1.2	1.9	0.95	2.5 2.1	0.45 0.15	0.53 0.45	0.2	0.1